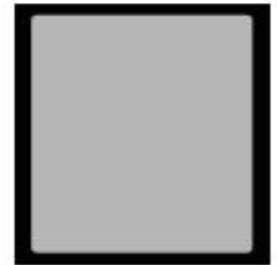


КРИСТАЛЛ ДИОДА ШОТТКИ 1200В / 10А

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Преобразователи для индукционного нагрева
- ◆ Высокочастотные преобразователи частоты
- ◆ Высокочастотные модуляторы
- ◆ Промышленные контроллеры электроприводов
- ◆ Корректоры коэффициента мощности
- ◆ Импульсные источники питания
- ◆ Инверторы напряжения для солнечных батарей
- ◆ Гибридные автомобили
- ◆ Военные коммуникационные приборы



V_{RRM}	1200	В
I_F	10	А
Q_C	57	нКл

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Обеспечивают высокую плотность тока при малых размерах кристалла
- ◆ Работают при максимальной температуре перехода 175°C
- ◆ Имеют близкий к нулю заряд обратного восстановления при переключениях
- ◆ Динамические характеристики переключения не зависят от величины прямого тока и температуры
- ◆ Частоты до 500 кГц, - снижение размеров фильтра и других пассивных компонентов
- ◆ Уменьшают, либо исключают активные или пассивные демпферные цепи
- ◆ Снижают энергию коммутационных потерь и обеспечивают их высокую эффективность не менее 90%
- ◆ Снижают электромагнитные помехи, излучаемые устройствами

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Условия измерения	Значение параметра	Единица измерения
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	V_{RRM}	$T_j = 25\text{ °C}$	1200	В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	V_{RSM}	$T_j = 25\text{ °C}$	1200	В
Максимальное постоянное блокируемое напряжение	V_{DC}	$T_j = 25\text{ °C}$	1200	В
Постоянный прямой ток	I_F	$T_C = 25\text{ °C}$	10	А
Ударный повторяющийся прямой ток	I_{FRM}	$T_C=25\text{ °C}$, $t_p=10\text{ мс}$, форма импульса - половина синусоиды	50	А
Ударный неповторяющийся прямой ток	I_{FSM}	$T_C=25\text{ °C}$, $t_p=10\text{ мкс}$	300	А
Рабочая температура перехода	T_j		от -55°C до 175°C	°C
Температура хранения	T_{stg}		от -55°C до 175°C	°C

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Условное обозначение	Условия измерения	Значение параметра			Единица измерения
			Мин.	Тип.	Макс.	
Постоянное прямое напряжения	V_F	$I_F=10A, T_j=25^{\circ}C$	-	1,63	1,8	В
		$I_F=10A, T_j=175^{\circ}C$	-	2,55	3	
Постоянный обратный ток	I_R	$V_R=1200В, T_j=25^{\circ}C$	-	50	100	мкА
		$V_R=1200В, T_j=175^{\circ}C$	-	100	200	
Заряд обратного восстановления	Q_C	$V_R=800В, I_F=10A$ $di/dt=200A/мкс, T_j=25^{\circ}C$	-	57	-	нКл
Общая емкость	С	$V_R=0В, T_j=25^{\circ}C, f=1МГц$	-	770	790	пФ
		$V_R=400В, T_j=25^{\circ}C, f=1МГц$	-	52	54	
		$V_R=800В, T_j=25^{\circ}C, f=1МГц$	-	50	51	

ОСНОВНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ

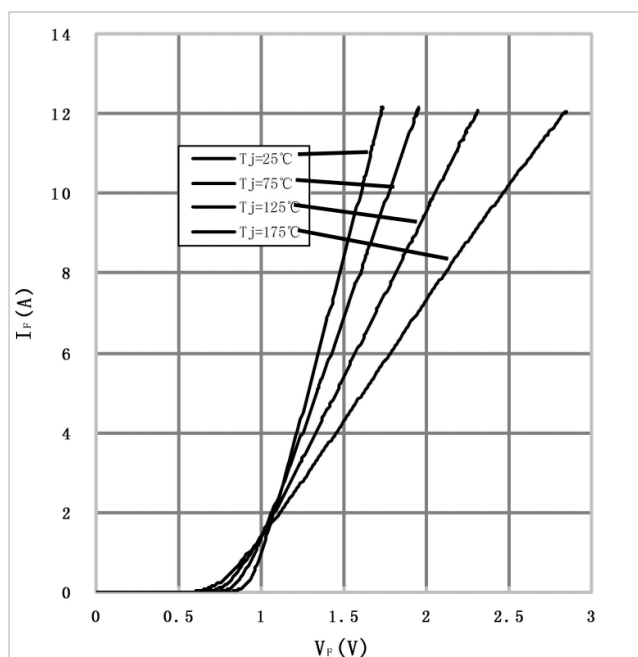


Рис. 1 – Зависимость прямого тока от прямого напряжения для различных значений T_j

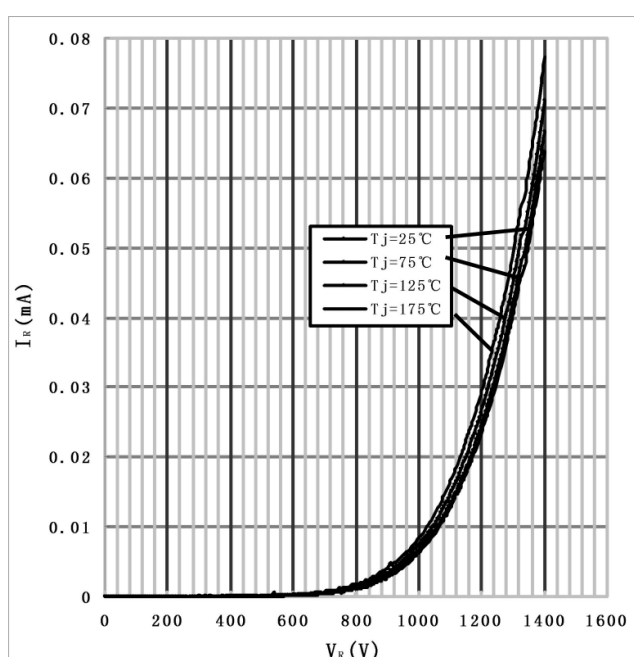


Рис. 2 – Зависимость обратного тока от обратного напряжения для различных значений T_j

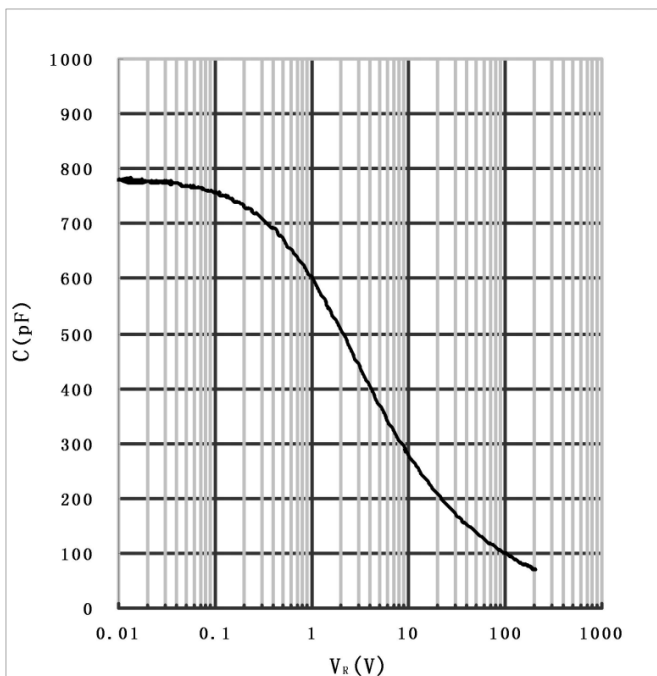
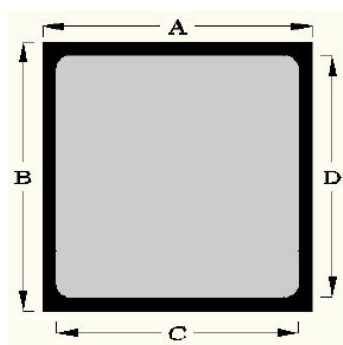


Рис. 3 – Зависимость общей емкости от обратного напряжения

ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ КРИСТАЛЛА

Наименование параметра	Значение параметра	Единица измерения
Размер кристалла	2,46 x 2,46	мм
Размер анодной площадки	2,19 x 2,19	мм
Размер анодного окна	1,75 x 1,75	мм
Толщина кристалла	375±25	мкм
Диаметр пластины	100	мм
Металлизация анода (Al)	4	мкм
Металлизация катода (Ag)	1,2	мкм
Тип пассивации	Полиимид	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ КРИСТАЛЛА



Обозначение стороны	Размеры, мм
A	2,46
B	2,46
C	1,75
D	1,75